直交変調型 EPWM 送信機の

高効率化および高精度化に関する研究

7314666 野田 昂志

1. まえがき

移動体通信機では、線形かつ高電力効率の電力増幅器(PA) が必要である.これらの要求を満たすために、包絡線パルス 幅変調(EPWM)方式[1]-[10],[13]が研究されている.EPWM 送 信機の中でも、直交変調型(QM)EPWM 送信機[3]-[10],[13]が 提案されている.QM 送信機には、様々な利点がある.第一 に、ΔΣ変調器(DSM)のようなパルス幅変調器を低いサンプリ ングレートで扱えることである.第二に、複雑な位相変調器 を必要としないため、全ディジタル化が可能であり、ディジ タル LSI 化に適している.第三に、直交座標からポーラ座標 に変換する際に非線形性を持つ[5]ポーラ変調型 EPWM 送信 機[1]-[2]と比較して量子化雑音が小さい.

QM-EPWM 送信機において,高効率を達成するためにバー スト RF 信号が出力されない「零」状態を表現できる 3 値 DSM[6]-[9],[13]が使用される.この方式は,正と負の両極性 のパルスを用いるため,アップコンバージョン(U/C)部の正側 と負側のそれぞれに PA を必要とし,さらに正と負の信号を 合成する合成器も必要とする[6],[9].あるいは,3値(正,負, 零)の入力信号で動作する PA を必要とする[7].前者の方式に, 合成器として通常トランスを使用する H-Bridge PA[9],[11]が ある.しかし,この構成ではトランスが存在するためにチッ プ面積や電力損失が大きくなるという欠点がある[12].一方, 後者の方式では精度の高い PA の3 値動作を必要とする.し かし,D 級 PA において2 つのトランジスタが同時にオフす ることによって出力インピーダンスがハイインピーダンスに なるため、零値を精度良く出力することが困難である.

そこで,我々は3値DSMにより生成した2値EPWM信号 を用いるQM-EPWM送信機を提案した.提案する送信機はマ イクロストリップアンテナのようなシングルエンドデバイス に接続するためのトランスを必要としない.また,従来の2 値DSMを用いた送信機[4]はキャリアのオフ状態を表現する ことができないが,提案する送信機は可能である.これは, キャリアが存在しない際の無駄な電力消費を抑えることがで きる.

一方,QM-EPWM 送信機では、DSM のサンプリング周波数
 (*f*_s),交互出力の周波数(*f*_i),搬送波周波数(*f*_c)が使用されている.
 しかし,*f*_s,*f*_i,*f*_cの最適な関係は現在議論されていない[7]-[9],
 [14].

本研究では、ディジタル信号処理シミュレーションとマイ クロ波回路シミュレーションを組み合わせて評価を行い、提 案する2値QM-EPWM送信機と従来の3値送信機の性能比較 を行う.また、2値QM-WPWM送信機において、変調精度 (EVM)及び電力付加効率(PAE)に対して最適な f_s , f_i , f_c の関係 を提案し、その妥当性を評価する.

2. QM-EPWM 送信機

2.1. 3 値 QM-EPWM 送信機

2つのD級PAを使用するH-BridgePAを用いる従来の3値 QM-EPWM送信機の構成図を図1に示す. 文献[7]で示される 論理回路の構成を簡略化するためにマルチプレクサ(MUX)を 使用する.図1における送信機の内部波形を図2に示す.DSM から出力した正と負及び零の論理出力を MUX1, 1', 2, 2'によ って搬送波周波数 fsに U/C する. MUX3, 3'は I-ch 及び Q-ch 信号を交互出力するために使用する. 次に, 交互出力した正 極及び負極の2つの2値 EPWM 信号をそれぞれ PA1 及び PA2 に入力する.最後に,負の極性に対応した論理信号をアナロ グ信号に変換し、合成器で極性を反転した後、正極性の信号 と合成する.結果として、PA に入力する3値 EPWM 信号が 出力される. DSM の正極性及び負極性の出力が"1"及び"0"の 時,出力される RF 信号の位相は 0°となる, DSM の正極性及 び負極性の出力が"0"及び"1"の時,出力される RF 信号の位相 は180°となる. DSM の正極性及び負極性の出力が共に"0"の 時, RF 信号は出力されない. この送信機は, 正極信号と負極 信号をそれぞれ増幅するために, 2 つの PA を用いる. また,

それらの信号を合成するために、合成器(トランス)を必要と する.従って、トランスによる電力消費と2つのPA及び合成 器による回路面積の増加が問題となる.

また, QM-EPWM 送信機において使用される PA に E 級 PA を使用した場合, RF バースト信号による包絡線変動が E 級 PAのドレインバイアスを変動させるため、インダクタを使用 しない D 級 PA が適している. D 級 PA に 3 値 EPWM 信号を 入力するためには、3 値で動作する PA あるいは、2 値で動作 する 2 つの PA とその出力電力を合成する合成器が必要不可 欠である.3値で動作するPAを使用する場合,RFバースト 信号が出力されていない際, PAの出力は零値である必要があ るため、アナログ動作が必要となる.しかし、D級 PA におい て、2つのトランジスタが同時にオフすることによって、出力 インピーダンスがハイインピーダンスとなるため, EVM が劣 化する[8]. そのため, QM-EPWM 送信機に対しては, D 級 PA の2値動作が適している.また,従来3値 OM-EPWM 送信機 に用いる H-Bridge D 級 PA の回路図を図 3 に示す. これは, 図1に示す PA1, PA2, 及び合成器と等価である. H-Bridge D 級 PA は、1 対の n-MOSFET を持つ 2 つの D 級 PA 及び負極 性の信号を変換する合成器としてのトランス, Cs, Ls の直列 共振回路によって構成される.

2.2. 2 值 QM-EPWM 送信機

提案する2値QM-EPWM送信機の構成図を図4に示す.この構成では、PAの2値動作及び合成器を使用しないシングル エンド出力が可能である.図4の送信機の内部波形を図5に 示す.3値QM-EPWM送信機の負極性部分を除去している. この送信機の動作は、EPWM部の負極性を除去したこと以外 は、図2に示す動作と同様である.負極性を除去することに より、RF信号にレベルオフセットが加えられる.しかし、こ のレベルオフセットはRF信号の帯域外であるため、PA内の 帯域通過フィルタ(BPF)によって除去される.シングルエンド D級PAの回路図を図6に示す.このD級PAは、1対のn-MOSFET及びCsとLsの直列共振回路により構成される.

図3,6の回路において、トランジスタの動作、トランジス タから見た出力インピーダンス、負荷抵抗での消費電力が等 価となるように設計を行っている.









3. f_s, f_iの最適化

DSMにより、f_sのサンプリングレートでパルス幅変調した 信号を、搬送波周波数f_cにU/Cする.さらに、I-chとQ-chの 信号が相互干渉を起こすのを防ぐため、f_iの周波数で交互出力 する.それらは時間軸で考えた場合、パルスを適切な間隔に 区切るという動作を行うことになる.このU/C及び交互出力 に用いられる周波数に不適切な値を用いた場合、QM-EPWM 送信機において、復調が不可能となる.以下にf_sf_iに関して EVM が最適な値となる条件式を示す.

(I) fs と fc の条件式

 $f_s = 2^m f_c \ (m = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots)$ (1) $f_s \le f_c$ (2)

 $(II) f_i \ge f_c の条件式$

$f_i=2^nf_c\ ({\rm n}=0,\pm1,\pm2,\cdots)$	(3)
$f_i \leq 2f_c$	(4)
$f_s \neq f_i$	(5)

(6)

 $(III) f_i \ge f_s の条件式$

 $f_i \ge f_s$

式(1)-(6)の必要性を説明する.式(1)-(4),(6)が満たされない 場合,U/C 又は交互出力後に RF 信号の一部のパルスが消失 する.そのため,情報の欠落が生じ,復調することが不可能 となる.また,提案する2値QM-EPWM送信機では,U/C後 の出力平均値が0とならないため,DC付近にスプリアスが 発生する.さらに,交互出力を行うと,信号成分が f_i の周波 数でミキシングされ,エイリアスが発生する.そのため,交 互出力を行った際,DC付近に発生したスプリアスがミキシン グされる. $f_s = f_i$ 時,交互出力によりミキシングされたDC付 近のスプリアスのエイリアスが RF 信号と干渉する.そのた め,式(5)が必要となる.

4. シミュレーション方法

シミュレーション構成図を図7に示す.まず, Mathworks 社 の MATLAB/Simulink を使用し, 16-QAM のベースバンド信号 を生成する.そして,その信号を I-ch と Q-ch の信号に分離す る.次に,ロールオフフィルタによりそれぞれの信号をアッ プサンプリング及び帯域制限する.その後,信号を EPWM 変 調し,バースト信号を生成する.生成した EPWM 信号は, Agilent Technologies 社の ADS 上で設計した PA に入力し,増











幅及び必要な周波数帯域のみを PA から出力する. そして, 再 び信号を MATLAB/Simulink に入力し, 直交検波する, その後, 信号をロールオフフィルタによりダウンサンプリング及び帯 域制限し, ベースバンド信号を復調する. 尚, H-Bridge D 級 PA では, トランスとして理想トランスを用いる.

本研究では、比較対象として PA を使用しない場合におい ても、シミュレーションを行った.この場合において、PA と 同じ帯域幅の BPF を MATLAB/Simulink 上で設計し、PA に代 用した.

表 1 及び表 2 にそれぞれ MATLAB/Simulink と ADS 上での シミュレーション諸元を示す.

4.1.3 値及び2値 QM-EPWM 送信機の比較

従来の3値QM-EPWM送信機と提案する2値QM-EPWM送信機の性能の比較を行う.評価指標は、式(7)(8)に示す電力 増幅器の電力効率を表すPAE,送信側と復調側の信号点の誤 差性能を表すEVMを用いる.

$$PAE = \frac{\text{H} \pi \pi \pi n - \Lambda \pi \pi n}{\text{H} \pi \pi \pi n} \times 100(\%)$$
(7)

$$EVM = \frac{誤 差 < f > h \nu o 実 劾値}{j 値 < f > h \nu o 実 劾値} (dB)$$
 (8)

搬送波周波数 f_c は 0.5~2 GHz の範囲で変化させ, DSM サン プリング周波数 f_s 及び交互出力周波数 f_i は 0.5GHz に固定し てシミュレーションを行う.

4.2. fs, fiの最適値の決定及び従来値との比較

始めに *f*s, *f*iの最適値を決定する。評価指標は,式(7)に示さ れる EVM を用いる. *f*cは 1GHz に固定, *f*sは 0.5*fc*~4*f*c, *f*iは 0.5*fc*~8*f*cの範囲で変化させ,シミュレーションを行う.そして, EVM が最大となる *f*s, *f*iの最適値を決定する.

次に上記で決定した f_s, f_iの最適値と従来値である f_s=f=0.5f_c を用いて,式(7)(8)で示される PAE 及び EVM の比較を行う. f_cは 0.5~2 GHz の範囲で変化させ, シミュレーションを行う.





表 1. MATLAB/Simulink 諸元



表 2. ADS 諸元

タイムステップ			$1/(100 f_c)$		
電力増幅器 (PA)	n-MOSFET	ゲート長	0.18 µm		
		総合ゲート幅 (Wg)	$10 \ \mu m \times 30 \ finger$		
	π.	TEE (V _{DD})	1.8 V		
	入力電量	E上段 (Vin2, Vin2')	$0.2 \sim 2.5 \text{ V}$		
	入力電品	E下段(Vin1, Vin1')	$0.2\sim 0.9 \; V$		
	直列 共振回路	Cs	$1.59 \times 10^{-3} / f_c$		
		L_s	15.9 / fc		
		Q11	2		
	負荷	苛抵抗 (R _L)	50 Ω		



図8 fc 対 PAE (fs=fi=0.5GHz)

5. シミュレーション結果

5.1. 3 値及び 2 値 QM-EPWM 送信機の比較

H-Bridge D 級 PA 及びシングルエンド D 級 PA の PAE を図 8 に示す. H-Bridge D 級 PA には方形波及び 3 値 EPWM 信号, シングルエンド D 級 PA には方形波及び 2 値 EPWM 信号を入 力している. 3 値入力時と 2 値入力時を比較した場合,それ ぞれの PAE はほぼ同値である.方形波入力及び 16-QAM 信号 入力時の PAE は,どちらの PA においても搬送波周波数 1GHz でそれぞれ約 75%及び 35%であった.変調信号入力時に PAE が減少する原因は,DSM でのバックオフの影響及び PA で信 号と共に増幅している量子化雑音を除去して信号成分のみの PAE を算出しているためである.

3 値及び2 値 EPWM 信号を用いた際の, PA を使用しない 場合あるいは,使用した場合の EVM を図9に示す. PA を使 用しない場合の EVM は3 値信号と2 値信号を用いた場合で ほぼ同値である.この際,3 値及び2 値どちらの信号を用い た場合においても,fcに依存して,EVM は増加している.こ れは,ベースバンド信号のシンボルレート(fsym)は固定してい るが,DSM のサンプリングレートはfcに比例して可変として いるためである.結果として,fc が増加するにつれて,DSM のオーバーサンプル率は増加し,量子化雑音は減少する.

5.2. fs, fiの最適値の決定及び従来値との比較

 $f_c \& 1$ GHz に固定、 f_s , $f_i \&$ 変化させた際の EVM 判定表を 表 3 に示す.上段は式(1)-(6)の条件より,下段はシミュレーシ ョンより判定した結果を示す.表 3 より,式(1)-(6)を満たす条 件は, $f_s=f_r=0.5f_c \text{ or } f_s=0.5f_c \text{ and } f_r=2f_c \text{ or } f_s=f_c \text{ and } f_r=2f_c \text{ or } g_s=f_c \text{ or } g_$

次に従来値である $f_s=f_s=0.5f_c$ と上記で得た $f_s=0.5f_c$ and $f_s=2f_c$ or $f_s=f_c$ and $f_s=2f_c$ の条件下でシミュレーションを行い, EVM 及 び PAE を算出した. 図 10, 11 にそれぞれ EVM 及び PAE を 示す. 図 10 より f_c が小さい時,提案する f_s , f_i の値を用いる と従来よりも EVM が増加している. これは, f_s が増加したこ とによる DSM のオーバーサンプル率の増加,また, f_i が増加 したことにより,交互出力によるミキシングノイズが帯域外 に発生し,雑音が減少したためである. 1GHz 時の PA ありの



図9 f_c 対 EVM ($f_s=f_i=0.5$ GHz)

表 3. EVM 判定表

	\int_{i}	$f_i = 0.5 f_c$		$f_i = f_c$		$f_i=2f_c$		$f_i \ge 4 f_c$	
f_s		EVM	判定	EVM	判定	EVM	判定	EVM	判定
$f_s=0.5f_c$	条件式	-	0	-	×	-	0	-	×
	シミュレーション	-41.8 dB	0	-10.1 dB	×	-43.8 dB	0	-8.4 dB	×
$f_s = f_c$	条件式	-	×	-	×	-	0	-	×
	シミュレーション	-19.2 dB	Δ	-10.1 dB	×	-44.2 dB	0	-8.4 dB	×
$f_s=2f_c$	条件式	-	×	-	×	-	×	-	×
	シミュレーション	-17.9 dB	Δ	-9.3 dB	×	-22.0 dB	Δ	-8.2 dB	×
$f_s \ge 4f_c$	条件式	-	×	-	×	-	×	-	×
	シミュレーション	-17 5 dB	~	-0 0 dB	¥	-20 6 dB	~	-8.1 dB	×



図11 fc対 PAE (fs及びfi変化)

EVM は,最も高い値を示した $f_s=f_c$ and $f=2f_c$ と従来の $f_s=f_s=0.5f_c$ でそれぞれ約-40dB 及び-36dB を示し,前者では約 4dB 改善 した.また,図 11 より,1GHz 時の信号成分のみの PAE は, $f_s=f_c$ and $f=2f_c$ と従来の $f_s=f_s=0.5f_c$ でそれぞれ約 49%及び 35%を 示し,前者では約 14%増加した.これは,EVM の時と同様の 理由で雑音が減少し,信号成分の増幅効率が増加したためで ある.これらの結果より, $f_s=f_c$ and $f=2f_c$ が最適値であるとい える.

6. まとめ

本研究では、3 値 QM-EPWM 送信機の負極側を除去した 2 値 QM-EPWM 送信機の提案及び DSM サンプリング周波数 f_s , 交互出力周波数 f_i の最適化を行った. ディジタル信号処理シ ミュレーションとマイクロ波回路シミュレーションを組み合 わせて評価を行った結果, PAE 及び EVM は共に同等の値を 示し,提案する送信機では従来の送信機と同等の性能で回路 面積の大幅な削減が期待できる.また、2 値送信機において, 提案する $f_s=f_c$ and $f_s=2f_c$ 時と従来の $f_s=f_s=0.5f_c$ 時で,シミュレー ションを行い, PAE 及び EVM を比較した.その結果,提案す る f_s , f_i では 1GHz 時に PAE は約 14%増加し, EVM は約 4dB 改善した.

文献

- H. Adachi and M. Iida, "Transmitting circuit and equipment," JP Patent Application, P2002-45388, Feb. 2002.
- [2] Y. Wang, "An improved Kahn Transmitter Architecture Based on Delta-Sigma Modulation," 2003 IEEE MTT-S Int. Microw. Symp. Dig., vol. 2, pp.1327-1330, June 2003.
- [3] Y. Wang, "A class-S RF amplifier architecture with envelope deltasigma modulation," IEEE Radio & Wireless Conference, RAWCON2002, pp. 177-179, 2002.
- [4] Helaoui, M., Hatami, S., Negra, R., Ghannouchi, F.M., "A Novel Architecture of Delta-Sigma Modulator Enabling All-Digital Multiband Multistandard RF Transmitters Design", IEEE Trans. CAS II: Express Briefs, pp. 1129 – 1133, vol. 55, no.11, Nov. 2008.
- [5] M. L. S. Penaloza, G. Baudoin, M.Villegas, "A Cartesian Sigma-Delta Transmitter Architecture", IEEE Radio and Wireless Symp. pp. 51-54, 2009.
- [6] N. V. Silva, A. S. R. Oliveira, and N. B. Carvalho, "Design and Optimization of Flexible and Coding Efficient All-Digital RF Transmitters," IEEE Trans. Microw. Theory Tech., vol. 61, no. 1, Jan. 2013.
- [7] H. Izumi, M. Kojima, Y. Umeda and O. Takyu, "Comparison between quadrature- and polar-modulation switching-mode transmitter with pulse-density modulation," International Conference on Advanced Communication Technology (ICACT), pp. 1140 - 1145, Jan. 2013.
- [8] T. Noda, W. Someya, Y. Iikura, Y. Umeda and Y. Kozawa, "Bi-level Quadrature-modulation low-pass EPWM transmitter using half side of tri-level $\Delta\Sigma$ modulator," 2015 IEEE PAWR, pp. 1–3, Jan 2015.
- [9] R. Hezar, L. Ding, J. Hur and B. Haroun, "A 23dBm fully digital transmitter using ΣΔ and pulse-width modulation for LTE and WLAN applications in 45nm CMOS," 2014 IEEE RFIC Symp., pp. 217-220, June 2014.
- [10] F. M. Ghannouchi, S. Hatami, P. Aflaki, M. Helaoui, and R. Negra, "Accurate Power Efficiency Estimation of GHz Wireless Delta-Sigma Transmitters for Different Classes of Switching Mode," IEEE Trans. Microw. Theory Tech., vol. 58, no. 11, Nov. 2010.
- [11] Liang Rong, F. Jonsson, Li-Rong Zheng, "A 11.4dBm 90nm CMOS H-Bridge resonating polar amplifier using RF Sigma Delta Modulation," IEEE ESSCIRC (ESSCIRC), pp. 307 – 310, Sept. 2011.
- [12] L.F. Tiemeijer, R.M.T. Pijper, C. Andrei, E. Grenados, "Analysis, Design, Modeling, and Characterization of Low-Loss Scalable On-Chip Transformers," IEEE Trans. Microw. Theory Tech., vol. 61, no. 7, July. 2013.

[13] T. Noda, W. Someya, Y. Iikura, Y. Umeda, Y. Kozawa, "Quadrature-modulation Transmitter with Tri-level Deltasigma Modulation for Generating Bi-level EPWM Signal," IEICE technical report, vol. 114, no. 318, MW2014-139, pp. 83-88, Nov. 2014.

本研究に対する学会発表など

(A) 査読付き論文 (0件)

なし

(B) 査読付き小論文 (2件)

<u>T. Noda</u>, W. Someya, Y. Iikura, Y. Umeda, Y. Kozawa, "Bi-level Quadrature-modulation Low-pass EPWM transmitter Using Half Side of Tri-level $\Delta\Sigma$ Modulator," RWW, TU3P-5, Jan. 2015.

<u>T. Noda</u>, Y. Umeda, Y. Kozawa, "Optimization of DSM Sampling Frequency and Interleaving Frequency for Bi-level Quadraturemodulation EPWM Transmitterk," NCSP'16, 発表予定.

(C) 査読なし論文 (2件)

<u>野田 昂志</u>, 染谷 和, 飯倉 祥晴, 楳田 洋太郎, 小澤 佑介, 3 値 ΔΣ変調器により生成した 2 値包絡線パルス幅変調信号を用いる 直交変調型送信機," マイクロ波研究会(MW)信学技報, vo.114, no.318, pp.83-88, Nov.2014.

染谷 和, <u>野田 昂志</u>, 楳田 洋太郎, 小澤 佑介, "3 値出力Δ-Σ変 調器を用いた直交変調型 EPWM 送信機における D 級電力増幅 器の2 値および3 値駆動の比較"マイクロ波研究会(MW)信学 技報, vo.114, no.391, pp.99-104, Jan.2015.

- (D) 学会大会等の口頭発表・ポスター発表(1件) <u>野田 昂志</u>, 楳田 洋太郎, 小澤 佑介, 吉田 智洋, 末光 哲也, "直交変調型 EPWM 送信機 RF 回路の InGaAs 系 HEMT を用い た設計",電子情報通信学会東京支部学生会研究発表会, C-2-122, Mar.2014.
- (E) 特許 (1件)

棋田 洋太郎, 野田 <u>昂志</u>, 染谷 和, 飯倉 祥晴,
特願 2014-204904 2014/10/3
信号処理装置及び送信装置.